В начало <u>Курсы</u> <u>ФИиВТ</u> <u>09.03.04 Программная инженерия(Очная) ПС</u> <u>11 Разработка программных систем</u> <u>4 семестр</u>

(09.03.04 11 4 сем о)Физика Дополнительные виды работ <u>Полупроводниковый диод (защита)</u>

Тест начат Понедельник, 10 Июнь 2024, 10:33

Состояние Завершенные

Завершен Понедельник, 10 Июнь 2024, 10:39

Прошло 6 мин. 4 сек.
времени

Баллы 5,00/6,00

Оценка 3,33 из 4,00 (83%)

Вопрос 1
Верно

Приведите в соответствие выражения, приведенные ниже:

Зоны разрешенных энергий валентных электронов относительно широкие потому, что испытывают...

Зоны разрешенных энергий электронов, близких к ядру, относительно узкие потому, что испытывают...

сильное влияние соседних атомов

слабое влияние соседних атомов

Ваш ответ верный.

Баллов: 1,00 из 1,00

Вопрос 2
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника $n$ – типа.
A
<u>B</u>
-
Буква Б обозначает
Выберите один ответ:
Special replination of the
<ul><li>зону проводимости</li><li>валентную зону</li></ul>
донорный уровень       х      донорный уровень       донорный       донорный уровень       донорный уровень       донорный уров
Ваш ответ неправильный.
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Укажите верные утверждения для полупроводника <b>р-типа</b> :
Выберите один или несколько ответов:
✓ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✓
Уровень Ферми при Т = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔
Уровень Ферми при Т = 0° К находится в середине зоны запрещенных энергий
□ Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны
Ваш ответ верный.
раш ответ верпыи.

Вопрос 4				
Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
При контакте двух полупроводников различного типа проводимости условие равновесия в области контакта достигается при				
Выберите один или несколько ответов:				
✓ равенстве тока основных и неосновных носителей ✔				
выравнивании уровней Ферми обоих полупроводников      ✓				
уменьшении тока основных носителей в е раз				
установлении уровня Ферми в n-полупроводнике ниже, чем в p-полупроводнике				
установлении уровня Ферми в n-полупроводнике выше, чем в p-полупроводнике				
y				
Ваш ответ верный.				
Вопрос <b>5</b>				
Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
Укажите, как будут меняться свойства полупроводни При повышении температуры диода ток неосновных на При понижении температуры диода ток неосновных При понижении температуры диода ток неосновных При понижении температуры диода ток основных но Ваш ответ верный.	к носителей осителей носителей	увеличивается  увеличивается  уменьшается  уменьшается		
Вопрос <b>6</b> Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
Укажите <u>изменения в вольт-амперной характеристике</u> полупроводникового диода, если его нагреть до +40° C.				
сопротивление диода при прямом включении	уменьшится	<b>✓</b>		
сопротивление диода при обратном включении	уменьшится	<b>✓</b>		
Ваш ответ верный.				